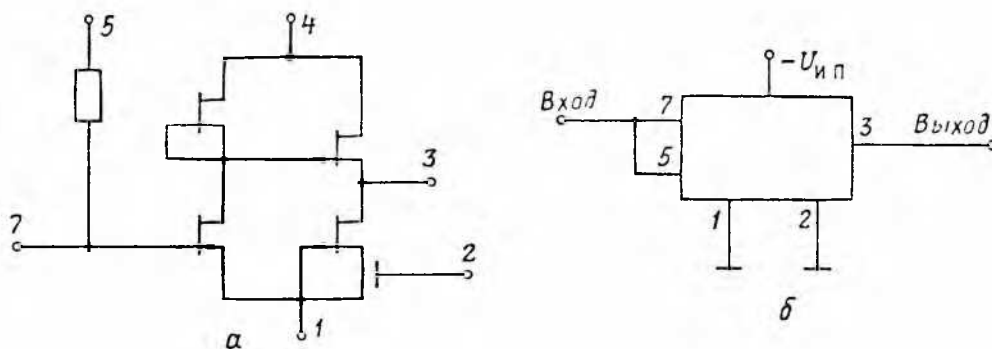


**504УН1А, 504УН1Б, 504УН1В,
К504УН1А, К504УН1Б, К504УН1В, 504УН2А, 504УН2Б,
504УН2В, К504УН2А, К504УН2Б, К504УН2В**

Малощумящие усилители низкой частоты с высоким входным сопротивлением. Могут использоваться для селективных усилителей, генераторов синусоидальных и релаксационных колебаний низкой частоты и т. д.



Принципиальная схема (а) и типовая схема включения (б) ИМС 504УН1, К504УН1, 504УН2, К504УН2

Параметры ¹	Режим измерения	504УН1, 504УН2 К504УН1, К504УН2		
		А	Б	В
$U_{ип}, В$	—	$-12 \pm 1,2$	$-12 \pm 1,2$	$-12 \pm 1,2$
$I_{пот}, мА$	$U_{вх} = 0; R_{н} = \infty$	$\frac{5}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{5}{10}$
$K_{y \nu}$	$f = 1 \text{ кГц}; U_{вх} = 1 \text{ мВ}$	$\frac{20 \dots 60}{10 \dots 60}$	40...120	$\frac{80 \dots 200}{80 \dots 260}$
$U_{вых \Delta max}, В$	$f = 1 \text{ кГц}; R_{н} = 3 \text{ кОм}$	$\frac{0,5}{0,2}$	0,5	0,5
$U_{ш вх}, мкВ$	$f = 5 \dots 10 \text{ кГц}; R_{н} = \infty$	3^2	3^2	3^2
		$\frac{5^3}{10^4}$	$\frac{5^3}{10^4}$	$\frac{5^3}{10^4}$

¹ При номинальном напряжении источника питания $-12 В$ и температуре $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$.

² Для 504УН1А, 504УН1Б, 504УН1В, К504УН1А, К504УН1Б, К504УН1В.

³ Для 504УН2А, 504УН2Б, 504УН2В.

⁴ Для К504УН2А, К504УН2Б, К504УН2В.

В случае применения микросхем 504УН1, 504УН2, К504УН1 и К504УН2 при закорачивании выводов 5 и 1 внутренний резистор сопротивлением 0,3...4 МОм может служить сопротивлением утечки затвора входного транзистора ИМС. Если внутренний резистор не используется, выводы 5 и 7 необходимо закоротить. Транзисторы микросхем сохраняют усилительные свойства до частот 1...2 МГц.